

NPN SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/366

Devices

2N3498	2N3499	2N3500	2N3501
2N3498L	2N3499L	2N3500L	2N3501L

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV
JANS

MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N3498* 2N3499*	2N3500* 2N3501*	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	100	150	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	100	150	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6.0	6.0	Vdc
Collector Current	I_C	500	300	mAdc
Total Power Dissipation	P_T	@ $T_A = 25^{\circ}C$ (1)	1.0	W
		@ $T_C = 25^{\circ}C$ (2)	5.0	W
Operating & Storage Junction Temp. Range	T_J, T_{stg}	-55 to +200		$^{\circ}C$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance: Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	35	$^{\circ}C/W$
Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	175	

*Electrical characteristics for "L" suffix devices are identical to the "non L" corresponding devices

1) Derate linearly 5.71 W/ $^{\circ}C$ for $T_A > 25^{\circ}C$

2) Derate linearly 28.6 W/ $^{\circ}C$ for $T_C > 25^{\circ}C$



TO-5*
2N3498L, 2N3499L
2N3500L, 2N3501L



TO-39* (TO-205AD)
2N3498, 2N3499
2N3500, 2N3501

*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^{\circ}C$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 10$ mAdc	2N3498, 2N3499 2N3500, 2N3501	$V_{(BR)CEO}$	100 150	Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 50$ Vdc	2N3498, 2N3499	I_{CBO}		50 η Adc
$V_{CB} = 75$ Vdc	2N3500, 2N3501			50 η Adc
$V_{CB} = 100$ Vdc	2N3498, 2N3499			10 μ Adc
$V_{CB} = 150$ Vdc	2N3500, 2N3501			10 μ Adc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 4.0$ Vdc		I_{EBO}		25 η Adc
$V_{EB} = 6.0$ Vdc				10 μ Adc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics		Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS ⁽³⁾					
Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 0.1 \text{ mA dc}, V_{CE} = 10 \text{ V dc}$	2N3498, 2N3500 2N3499, 2N3501	h_{FE}	20 35		
$I_C = 1.0 \text{ mA dc}, V_{CE} = 10 \text{ V dc}$	2N3498, 2N3500 2N3499, 2N3501		25 50		
$I_C = 10 \text{ mA dc}, V_{CE} = 10 \text{ V dc}$	2N3498, 2N3500 2N3499, 2N3501		35 75		
$I_C = 150 \text{ mA dc}, V_{CE} = 10 \text{ V dc}$	2N3498, 2N3500 2N3499, 2N3501		40 100	120 300	
$I_C = 300 \text{ mA dc}, V_{CE} = 10 \text{ V dc}$	2N3500 2N3501		15 20		
$I_C = 500 \text{ mA dc}, V_{CE} = 10 \text{ V dc}$	2N3498 2N3499		15 20		
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 10 \text{ mA dc}, I_B = 1.0 \text{ mA dc}$	All Types		$V_{CE(sat)}$		0.2
$I_C = 300 \text{ mA dc}, I_B = 30 \text{ mA dc}$	2N3498, 2N349	0.6			
$I_C = 150 \text{ mA dc}, I_B = 15 \text{ mA dc}$	2N3500, 2N3501	0.4			
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 10 \text{ mA dc}, I_B = 1.0 \text{ mA dc}$	All Types	$V_{BE(sat)}$		0.8	Vdc
$I_C = 300 \text{ mA dc}, I_B = 30 \text{ mA dc}$	2N3498, 2N3499		1.4		
$I_C = 150 \text{ mA dc}, I_B = 15 \text{ mA dc}$	2N3500, 2N3501		1.2		

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Forward Current Transfer Ratio, Magnitude $I_C = 20 \text{ mA dc}, V_{CE} = 20 \text{ V dc}, f = 100 \text{ MHz}$		$ h_{fe} $	1.5	8.0	
Output Capacitance $V_{CB} = 10 \text{ V dc}, I_E = 0, 100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$	2N3498, 2N3499 2N3500, 2N3501	C_{obo}		10 8.0	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 0.5 \text{ V dc}, I_C = 0, 100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$		C_{ibo}		80	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-On Time $V_{EB} = 5 \text{ V dc}; I_C = 150 \text{ mA dc}; I_{B1} = 15 \text{ mA dc}$		t_{on}		115	ns
Turn-Off Time $I_C = 150 \text{ mA dc}; I_{B1} = I_{B2} = -15 \text{ mA dc}$		t_{off}		1150	ns

SAFE OPERATING AREA

DC Tests					
$T_C = +25^\circ\text{C}, t_r \geq 10 \text{ ns}; 1 \text{ Cycle}, t = 1.0 \text{ s}$					
Test 1					
$V_{CE} = 10 \text{ V dc}, I_C = 500 \text{ mA dc}$	2N3498, 2N3499				
$V_{CE} = 16.67 \text{ V dc}, I_C = 300 \text{ mA dc}$	2N3500, 2N3501				
Test 2					
$V_{CE} = 50 \text{ V dc}, I_C = 100 \text{ mA dc}$	All Types				
Test 3					
$V_{CE} = 80 \text{ V dc}, I_C = 40 \text{ mA dc}$	All Types				
Clamped Switching					
$T_A = +25^\circ\text{C}$					
Test 1					
$I_B = 85 \text{ mA dc}, I_C = 500 \text{ mA dc}$	2N3498, 2N3499				
$I_B = 50 \text{ mA dc}, I_C = 300 \text{ mA dc}$	2N3500, 2N3501				

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300 μs , Duty Cycle \leq 2.0%.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.